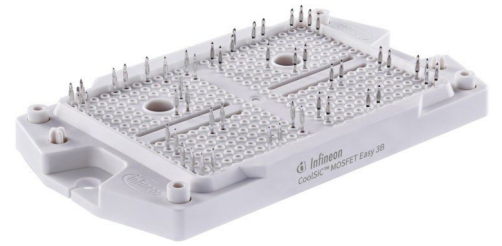


EasyPACK™ および EasyDUAL™ 1200 V CoolSiC™ MOSFET M1H パワーモジュール

EasyPACK™ および EasyDUAL™ パワーモジュールは、第1世代 CoolSiC™ MOSFETから進化したM1Hテクノロジーを搭載したリードタイプの製品です。推奨 $V_{GS(on)}$ 15 V~18 Vおよび $V_{GS(off)}$ 0 V~5 Vと、ゲート駆動電圧範囲を大幅に拡大しました。また、オーバーシュートとアンダーシュートをカバーするために最大ゲートソース電圧を+23 Vと-10 Vに拡大しています。



$V_{GS(th)}$ の安定性向上により、スイッチング時のドリフトを大幅に低減し、同時に $R_{DS(on)}$ 性能を125°Cで約12%向上しました。なお、デバイスの基本コンセプトは変わらず、セルレイアウトやサイズにも変更はありません。

リードタイプには、Easy 1B、2B、3Bパッケージのそれぞれ6パック、3レベルNPC2、ハーフブリッジトポロジーがあります。インフィニオンは、この最初のフルCoolSiC™ EasyDUAL™ 3Bパワーモジュールにより、市場で最も幅広い産業用シリコンカーバイドのラインアップを提供します。

主な特長

- > Easy 1B、2B、3Bパッケージ
- > 1200 V CoolSiC™ MOSFET M1H (強化型第1世代)
- > 推奨ゲート駆動電圧ウィンドウを+15 V...+18 Vおよび0 V...-5 Vに拡大
- > 最大ゲートソース間電圧 +23 V ~ -10 Vに拡大
- > 過負荷時の最大温度 $T_{vjop}=175^{\circ}\text{C}$
- > 6パック、3レベルまたはハーフブリッジ構成
- > PressFITピン
- > TIM (熱伝導材料) 塗布済み (Easy 3B)

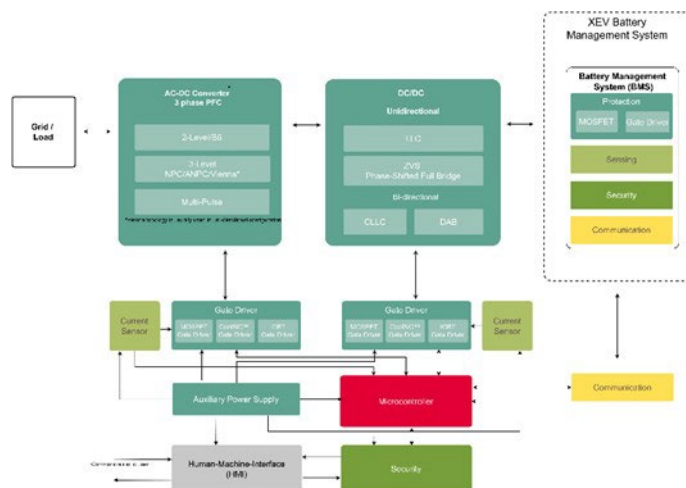
主な利点

- > 市場で最も幅広い産業用 SiC 製品のラインアップ
- > 標準的な CoolSiC™ MOSFET (M1) に比べて $R_{DS(on)}$ が12%向上
- > スwitching時のドリフトを低減

競合製品に対する優位性

- > 市場で最も幅広い産業用 SiC 製品のラインアップ

ブロック図



対象アプリケーション

- > サーボドライブ
- > UPS
- > EVチャージャー
- > 太陽光発電用インバータ

製品関連情報 / オンライン サポート

[製品ページ FS55MR12W1M1HB11NPSA1](#)

[製品ページ FF2MR12W3M1HB11BPSA1](#)

[製品ページ F3L8MR12W2M1HPB11BPSA1](#)

製品概要および製品データシート ページへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
FS55MR12W1M1HB11NPSA1	SP005551133	AG-EASY1B-3111
FF2MR12W3M1HB11BPSA1	SP005551090	AG-EASY3B-3111
F3L8MR12W2M1HPB11BPSA1	SP005562921	AG-EASY2B-3111

【 EasyPACK™ および EasyDUAL™ 1200 V CoolSiC™ MOSFET M1H パワーモジュール】

FAQ
1. When are these parts available?
> A: Now, but due to the current allocation situation, there might be some delay in supply
2. Is there a further roll-out of a bigger portfolio planned?
> A: Yes, we are already in the process of releasing more and more products with our Easy module in combination with the latest series of our CoolSiC™ MOSFET technology
3. Will you release parts for better thermal performance?
> A: Yes, we will also release modules with our pre-applied thermal interface material and also with our high-performance ceramic